

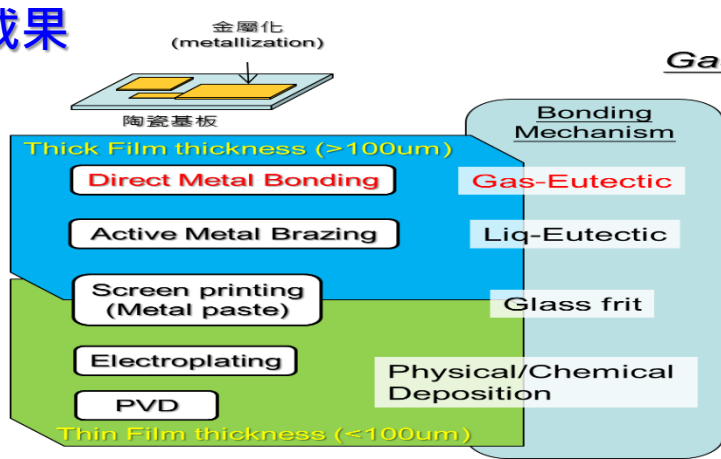


功率半導體用覆銅陶瓷基板技術

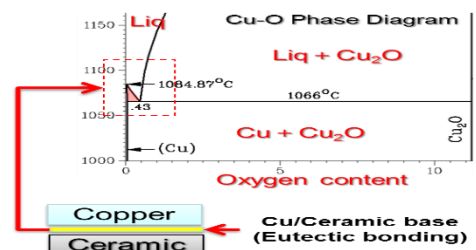
簡介

國內金屬化陶瓷基板產業導電層厚度極限在100um以下，藉由本計畫試量產平台技術開發，可建置金屬化陶瓷基板導電層厚度>200um之技術建立自主技術補足國內技術範圍不足的部分，更可由試量產平台建立，提供業者更快速的技術導入。

成果



Gas-eutectic Bonding method



- Keys of Technology**
- Raw Copper material
 - Oxygen partial pressure control
 - Temperature control
 - Metal/Ceramic Interface Reaction

